

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	14
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	14
1.5 ผลที่ได้จากการวิจัย	14
บทที่ 2 ทฤษฎี	15
2.1 นาโนและนาโนเทคโนโลยี	15
2.1.1 นาโน และนาโนเทคโนโลยี	15
2.1.2 สมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลยี	16
2.1.3 ประเภทของนาโนเทคโนโลยี	17
2.1.4 วิธีสร้างผลิตภัณฑ์และสิ่งของระดับนาโน	18

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved

2.2	เซ็นเซอร์แบบต่างๆ	19
2.2.1	หัวตรวจวัดทางชีวภาพ	20
2.2.2	หัวตรวจวัดก๊าซ	24
2.2.3	สภาพไว (Sensitivity)	26
2.2.4	เวลาการตอบสนอง (Response time, T_{90})	26
2.2.5	เวลาการคืนตัว (Recovery time, T_{90}^+)	27
บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง		28
3.1	อุปกรณ์หลัก	28
3.2	วัสดุ อุปกรณ์ย่อย	31
3.3	การทดลอง	36
3.3.1	การศึกษาการใช้เครื่องโฟกัสไอออนบีม	37
3.3.2	การเตรียมแผ่นรองรับ	38
3.3.3	การเตรียมเงื่อนไขต่างๆ	39
3.3.4	ศึกษาผลของเวลากับเงื่อนไขของค่าความหนา Z	40
3.3.5	การวิเคราะห์ผลที่เงื่อนไขต่างๆ	40
3.3.6	การสร้างขั้วไฟฟ้าสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์ชีวภาพ กับแบคทีเรียชนิด <i>E-coli</i>	40
3.3.7	การสร้างขั้วไฟฟ้าสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์ก๊าซ	41
บทที่ 4 ผลการทดลอง		42
4.1	ผลการเตรียมแผ่นรองรับ	42
4.2	ผลการเตรียมขั้วไฟฟ้าทองคำขาวระดับนาโน	43

4.2.1	ผลการสร้างเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาว ในแต่ละจุดระหว่างพื้นที่ของทองคำ	44
4.2.2	ผลจากการตรวจพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM)	53
4.2.3	ผลของเงื่อนไขค่าเวลาที่สัมพันธ์กับค่า Z	59
4.2.4	ผลจากการตรวจเครื่องสเปกโทรสโกปีแบบกระจายพลังงาน (EDS)	62
4.3	ผลการประยุกต์ใช้ขั้วไฟฟ้าทองคำขาวที่เตรียมด้วยโฟกัสไอออนบีม เป็นเซ็นเซอร์	66
4.3.1	ผลการทดสอบเซ็นเซอร์ชีวภาพ	66
4.3.2	เปรียบเทียบผลของเซ็นเซอร์ชีวภาพ	71
4.3.3	ผลการทดสอบเป็นเซ็นเซอร์ก๊าซ	72
4.3.4	เปรียบเทียบผลของเซ็นเซอร์ก๊าซ	74
บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ		75
5.1.	สรุปผลการทดลอง	75
5.1.1	สรุปการเตรียมแผ่นรองรับ	75
5.1.2	สรุปผลการทดลองเตรียมเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาว	75
5.1.3	สรุปผลการผลการใช้ขั้วไฟฟ้าทองคำขาวประยุกต์เป็นเซ็นเซอร์	76
5.1.3.1	สรุปผลการประยุกต์เป็นเซ็นเซอร์ชีวภาพ	76
5.1.3.2	สรุปผลการประยุกต์เป็นเซ็นเซอร์ก๊าซ	76
5.2	ข้อเสนอแนะ	77
เอกสารอ้างอิง		78

ภาคผนวก	83
ภาคผนวก ก รายละเอียดของเครื่องโฟกัสไอออนบีม	84
ภาคผนวก ข รายละเอียดของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม	119
ภาคผนวก ค วิธีการเตรียมขั้วไฟฟ้า	124
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ด้วย AFM	128
ภาคผนวก จ ผลงานวิชาการ	137
ประวัติผู้เขียน	159



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
3.1 ค่ากระแสกับค่าพลังงานของเครื่อง โฟกัสไอออนบีม รุ่น Quanta 200 3D ของบริษัท FEI Company	38
4.1 ผลการนำไฟฟ้าของพื้นที่สื่อน้ำแข็งที่เชื่อมด้วยเส้น ฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่เงื่อนไขต่างๆ	46
4.2 เปรียบเทียบขนาดความกว้างแถบเส้นโลหะทองคำขาว ที่วัดจาก SEM กับ AFM	57
4.3 แสดงค่าของ Atomic % บริเวณเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาว ของตัวอย่างที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 30 kV และค่ากระแสไฟฟ้าที่ 50 pA โดยแปรค่าศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนที่ค่าต่างๆ	62
4.4 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดลองเซ็นเซอร์ชีวภาพ กับผลการทดลองของคณะนักวิจัยอื่นๆ	71
4.5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดลองเซ็นเซอร์ก๊าซ กับผลการทดลองของคณะนักวิจัยอื่นๆ	74
ผ.ก. 1 ตารางเปรียบเทียบสมบัติของแคโทดชนิดต่างๆ	89
ผ.ก. 2 เปรียบเทียบธาตุหลักที่นำมาใช้ทำเป็น LMIS	105
ผ.ก. 3 เปรียบเทียบระหว่างลำอิเล็กตรอนกับลำไอออน	117

สารบัญภาพ

รูป	หน้า
1.1 การสร้างรูปเพิ่ม โดยใน (ก)เทคนิค EB-CVD และ (ข) เทคนิค FIB-CVD	3
1.2 เส้นนาโนคาร์บอนเชื่อมระหว่างขั้วไฟฟ้าทองคำโดยเทคนิค FIB-CVD และ EB-CVD	5
1.3 แสดงโครงสร้างสามมิติรูปสปริงนาโนที่สร้างโดย (ก) เทคนิค FIB-CVD และ (ข) เทคนิค EB-CVD	5
1.4 แบบจำลองการประดิษฐ์ Immunosensor	9
1.5 กระบวนการเคมีการติดแอนติบอดีกับผิวของขั้วไฟฟ้าทองคำ	11
1.6 (ก) การจำลองการกระจายเชื้อแบคทีเรีย <i>E-coli</i> และ (ข) วงจรไฟฟ้าของเซลล์ <i>E-coli</i> ที่ติดอยู่บนช่องขั้วไฟฟ้าทองคำแบบ interdigital	12
2.1 การเปรียบเทียบขนาดของวัสดุทางชีวภาพกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น	16
2.2 ส่วนประกอบของหัวตรวจวัดทางชีวภาพ	20
2.3 ลำดับขั้นการเกิดปฏิกิริยาของ Amperometric biosensor	22
2.4 แผนผังการทำงานของเซ็นเซอร์ชีวภาพ	23
2.5 ภาพแสดงลักษณะโมเลกุลของออกซิเจนไอออนที่เกาะอยู่ที่ผิวของผลึก จะทำปฏิกิริยากับ โมเลกุลของไอของก๊าซ	25
2.6 แผนผังแสดงหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ก๊าซ	25
3.1 (ก) เครื่องโฟกัสไอออนบีม (ข) ส่วนประกอบภายในเครื่องโฟกัสไอออนบีม	28
3.2 การพอกผิวด้วยเทคนิค FIB-CVD	29

3.3 เครื่องเคลือบทองคำและคาร์บอน	30
3.4 กล้องจุลทรรศน์แบบสแตอริโอไมโครสโคป	30
3.5 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM)	31
3.6 (ก) แผ่นกระจกสไลด์, (ข) แผ่นกระจกสไลด์ที่ถูกเคลือบด้วยทองคำ	31
3.7 Copper grid	32
3.8 คาร์บอนเทป	32
3.9 สายแพรสำเร็จรูป จากฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์	33
3.10 (ก) เอทานอล, (ข) ขวดแก้ว	33
3.11 Socket IC	34
3.12 Alcohol Simulator Model 34C	34
3.13 แผนภาพการดำเนินงานวิจัย	36
4.1 (ก) ภาพจากกล้องสแตอริโอไมโครสโคปของกระจกแผ่นรองรับถูกเคลือบด้วยทองคำ (ข) ภาพขยายด้วย SEM ของแผ่นรองรับถูกเคลือบด้วยทองคำ	42
4.2 ลักษณะการนำไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่สัมผัสทองคำบนแผ่นรองรับ (ก) ก่อน และ (ข) หลังจากทำการเชื่อมทางเดินของอิเล็กตรอนด้วยทองคำขาวด้วยเทคนิคFIB-CVD	44
4.3 ภาพจาก FIB แสดงตำแหน่งเส้นฟิล์มบางนาโนทองคำขาวที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ของทองคำ	45
4.4 ภาพ SEM แสดงตำแหน่งเส้นฟิล์มบางนาโนทองคำขาวที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ของทองคำ	45
4.5 ภาพ SEM แสดงลักษณะของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่เตรียมด้วยค่าศักย์ไฟฟ้า 10 kV และแปรค่าขนาดของ ลำไอออนในย่าน 10-400 pA ตามลำดับ	47
4.6 ภาพ SEM แสดงลักษณะของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่เตรียมด้วยค่าศักย์ไฟฟ้า 20 kV และแปรค่าขนาดของ ลำไอออนในย่าน 4-90 pA ตามลำดับ	48

4.7 ภาพ SEM แสดงลักษณะของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่เตรียมด้วยค่าศักย์ไฟฟ้า 30 kV และแปรค่าขนาดของ ลำไอออนในย่าน 10-500 pA ตามลำดับ	49
4.8 แสดงลักษณะของบริเวณพื้นที่ A และ B ของเงื่อนไข 30 kV-500 pA (ผลจาก SEM)	50
4.9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่วัดขนาดจากขอบนอกบริเวณพื้นที่ (A) ของเส้นกับค่ากระแสของลำไอออนบีมที่ใช้	51
4.10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่วัดขนาดจากขอบใน (B) ของเส้นกับค่ากระแสของลำไอออนบีมที่ใช้	51
4.11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการพอกเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวกับค่ากระแสลำไอออน	52
4.12 ภาพ AFM แสดงลักษณะของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่เตรียมด้วยค่าศักย์ไฟฟ้า 10 kV และแปรค่าขนาดของ ลำไอออนในย่าน 10-400 pA ตามลำดับ	53
4.13 ภาพ AFM แสดงลักษณะของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่เตรียมด้วยค่าศักย์ไฟฟ้า 20 kV และแปรค่าขนาดของ ลำไอออนในย่าน 4-90 pA ตามลำดับ	54
4.14 ภาพ AFM แสดงลักษณะของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่เตรียมด้วยค่าศักย์ไฟฟ้า 30 kV และแปรค่าขนาดของ ลำไอออนในย่าน 10-50 pAตามลำดับ	55
4.15 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวกับค่ากระแสลำไอออน	56
4.16 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวกับค่ากระแสลำไอออน	57
4.17 (ก) แสดง ภาพจาก SEM บริเวณของเงื่อนไขความหนา Z (ข) ภาพจาก FIB ที่ 30 kV, 50 pA บริเวณของเงื่อนไขความหนา Z	59
4.18 แสดงผลของเวลาที่มีความสัมพันธ์กับความหนา Z ที่ 30 kV, 50 pA	60
4.19 แสดงผลความกว้าง A และ B ที่สัมพันธ์กับความหนา Z ที่ 30 kV,50 pA	60
4.20 แสดงผลความกว้างของบริเวณ B ที่สัมพันธ์กับความหนา Z ที่ 30 kV,50 pA	61

4.21 ตำแหน่งบริเวณเส้นฟิล์มบางนาโนของทองคำขาวที่ถูกวิเคราะห์ด้วย EDS การวิเคราะห์แบบจุด ของตัวอย่างที่ค่าพลังงาน 30 kV และแปรค่าขนาดของ ลำไอออนในย่าน 50 pA	62
4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วย EDS บริเวณแผ่นทองคำที่เคลือบบนแผ่นรองรับกระจก	64
4.23 แสดงค่า Atomic% ของทองคำที่ถูกเคลือบบนแผ่นรองรับ และซิลิกอน ที่เป็นองค์ประกอบของแผ่นกระจกรองรับ	64
4.24 (ก) ภาพจาก SEM แสดงขั้วไฟฟ้าทองคำขาวแบบแบบอินเตอร์ดิจิตอล (ข) สายแพร่นำมาประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับเตรียมเซ็นเซอร์ <i>E-Coli</i>	66
4.25 ตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงของหัววัดเซ็นเซอร์ในอากาศ และในความเข้มข้นของ <i>E-Coli</i> 10^6 cfu/ml	67
4.26 ผลค่า I-V Curve ของเซ็นเซอร์ชีวภาพ	67
4.27 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง sensitivity ของเซ็นเซอร์ กับความหนาแน่นของ <i>E-coli</i>	69
4.28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าของหัววัดเซ็นเซอร์ในสารละลาย <i>E-Coli</i> กับความเข้มข้นของสารละลาย <i>E-Coli</i> ในช่วง 10^4 - 10^8 cfu/ml	70
4.29 ผลการเตรียมขั้วไฟฟ้าสำหรับประยุกต์ทำเป็นเซ็นเซอร์ก๊าซแบบ 4 ขั้วไฟฟ้า	72
4.30 ผลการทดสอบเซ็นเซอร์ก๊าซกับ ไอเอทานอล ความเข้มข้น 1000 ppm	73
ผ.ก. 1 (ก) องค์ประกอบและลักษณะการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) (ข) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	86
ผ.ก. 3 แสดงลักษณะของ Electron gun ที่มีไส้หลอดเป็นทั้งสแตน	87
ผ.ก. 4 ภาพภาคตัดขวางของเลนส์อิเล็กตรอน แสดงให้เห็นการเลี้ยวเบน ของลำอิเล็กตรอนเนื่องจากสนามแม่เหล็ก	90

<p>ผ.ก. 5 แสดงตัวอย่างการควบคุมลำอิเล็กตรอนโดยการควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ ให้แก่ขดลวดทองแดง รูป (A) ไม่ให้กระแสไฟฟ้าลำอิเล็กตรอนจะไม่เกิดการโฟกัส (B) ให้กระแสไฟฟ้าเล็กน้อยลำอิเล็กตรอนมีความยาวโฟกัสมาก (C) ให้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น ลำอิเล็กตรอนจะมีความยาวโฟกัสที่สั้นลง</p>	91
<p>ผ.ก. 6 แสดงการตรวจจับ Secondary electrons ด้วยหัวตรวจวัด photomultiplier</p>	92
<p>ผ.ก. 7 การทำงานและลักษณะของ Photomultiplier ใช้ขยายสัญญาณที่รับมา Scintillator</p>	92
<p>ผ.ก. 8 อันตรกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อลำอิเล็กตรอนตกกระทบกับผิวของสารตัวอย่าง</p>	94
<p>ผ.ก. 9 อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคกับอิเล็กตรอนในอะตอมที่ทำให้เกิดรังสีเอกซ์</p>	98
<p>ผ.ก. 10 ลักษณะสเปกตรัมที่วัดได้จากเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน</p>	99
<p>ผ.ก. 11 หัววัดสำหรับตรวจวิเคราะห์รังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน รวมถึงทรงกระบอกด้านบนใช้บรรจุไนโตรเจนเหลวเพื่อลดอุณหภูมิหัววัด</p>	100
<p>ผ.ก. 12 ผลึกซิลิกอน Si(Li) ที่เป็นหัวตรวจวัดรังสีเอกซ์</p>	101
<p>ผ.ก. 13 แสดงส่วนประกอบของหัวตรวจวัดรังสีเอกซ์</p>	101
<p>ผ.ก. 14 แสดงส่วนประกอบการทำงานในระบบทำงานของเครื่องสเปกโตมิเตอร์ รังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน</p>	102
<p>ผ.ก. 15 แสดงอันตรกิริยาระหว่างรังสีเอกซ์กับหัววัดที่ทำให้เกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮล</p>	102
<p>ผ.ก. 16 ระบบของ ไอออนบีม(FIB) และระบบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM)</p>	103
<p>ผ.ก. 17 ปลายหัวของ LMIS (Tip) ที่เกิดขึ้นจาก Cone ที่อยู่ในสนามไฟฟ้า และรัศมีของปลาย LMIS</p>	106
<p>ผ.ก. 18 ส่วนประกอบของ Ion beam column</p>	109
<p>ผ.ก. 19 หัวตรวจจับอิเล็กตรอนและ ไอออน และหลักการทํางาน</p>	113
<p>ผ.ก. 20 Gas injection system</p>	115
<p>ผ.ก. 21 ลักษณะการชนของลำไอออนบนผิวชิ้นงาน</p>	116

ลิขสิทธิ์ในทางวิทยาศาสตร์สงวนใหม่
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved

ผ.ข. 1 หลักการทำงานของเครื่อง AFM	119
ผ.ข. 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์แรง Van der Waals ต่อระยะห่างระหว่าง tip และชิ้นงาน	120
ผ.ข. 3 ด้านซ้ายแสดงลักษณะของปลาย tip ที่มีขนาดใหญ่กว่ารายละเอียดของชิ้นงาน และด้านขวา แสดงภาพที่ได้จากกล้อง AFM	122
ผ.ข. 4 ด้านซ้ายแสดง tip ขณะสัมผัสกับชิ้นงานที่มีความสูง ด้านขวา แสดงภาพที่ได้จาก AFM ซึ่งจะเปลี่ยนไปจากความเป็นจริง	123
ผ.ค. 1 ขั้นตอนการทำงานตามวิธีการของ EBL	125
ผ.ค. 2 แผนภาพรายละเอียดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ถูกนำมาใช้ ในการสร้างโครงสร้างนาโนโดยวิธีการ EBL	126
ผ.ค. 3 เทคนิคการพอกโดยไอสารเคมีด้วยลำไอออน빔 (FIB-CVD) ของ FIB และ Gas injection system	127